

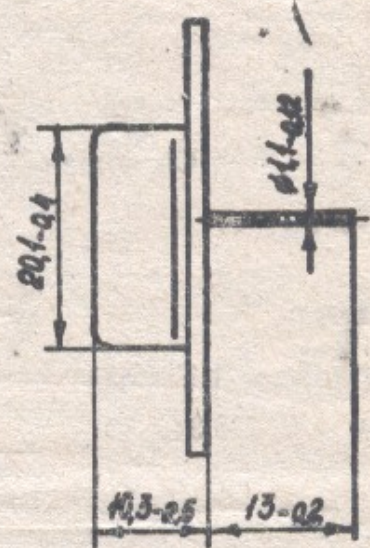
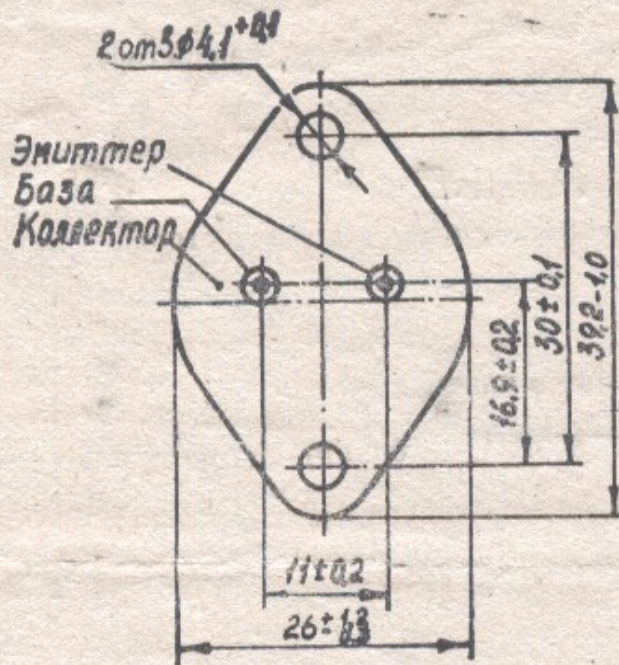


Транзисторы КТ808АМ, КТ808БМ, КТ808ВМ, КТ808ГМ

ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза-эпитаксиально-планарные мощные высоковольтные п-р-п транзисторы КТ808АМ, КТ808БМ, КТ808ВМ, КТ808ГМ в металлокерамическом корпусе, предназначенные для работы в усилительных и переключающих схемах.

Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 2, 2.1, 3.1.



Основные электрические параметры

(при температуре окружающей среды +25°C)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($I_K=2$ А, $U_{КЭ}=3$ В)	$h_{21Э}$	20	125
Обратный ток коллектора, мА ($U_{КБ}=250$ В КТ808АМ) ($U_{КБ}=160$ В КТ808БМ) ($U_{КБ}=135$ В КТ808ВМ) ($U_{КБ}=80$ В КТ808ГМ)	КБО		2
Обратный ток эмиттера, мА ($U_{ЭБ}=4$ В)	ЭБО		15
Граничное напряжение коллектор-эмиттер, В ($I_K=100$ мА, $L=25$ мГн) КТ808АМ КТ808БМ КТ808ВМ КТ808ГМ	УКЭОгр		130 100 80 70
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_K=6$ А, $I_B=0,6$ А)	УКЭнас		2

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_K=6$ А, $I_B=0,6$ А)	УБЭнас		2,5
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{KЭ}=10$ В, $I_K=0,5$ А, $f=3$ МГц)	$ h_{21E} $	2,3	
Время рассасывания, мкс ($I_K=6$ А, $I_{B1}=I_{B2}=0,6$ А, $U_K=30$ В)	t_{pac}	2	

Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе:

Золото — 0,0003569 г.

Вывода транзисторов драгметаллов не содержат.

Содержание цветных металлов в одном транзисторе:

Медь — 2,4 г.

Сведения о приемке

Транзисторы КТ808АМ, КТ808БМ, КТ808ВМ, КТ808ГМ соответствуют техническим условиям А0.336.240 ТУ.

ОТК 924

Штамп ОТК

Перепроверка произведена _____ дата

Штамп ОТК